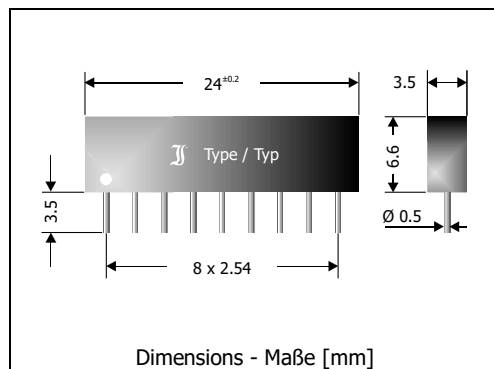


DAN803 / DAP803 / DA4148A/K (200 mW)
Small Signal Diode Arrays
Diodensätze mit Allzweckdioden

Version 2019-08-27



Nominal power dissipation
Nenn-Verlustleistung

200 mW

Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung

80 V

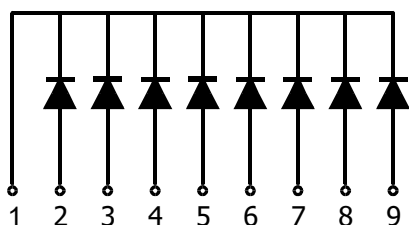
9-pin Plastic case
9-Pin Kunststoffgehäuse

24 x 3.5 x 6.6 [mm]

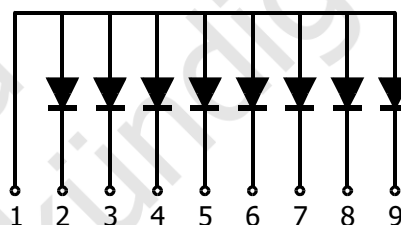
Weight approx. – Gewicht ca.

0.6 g

Standard packaging bulk
Standard Lieferform lose im Karton



"DAN" / DA4148"K" common cathodes / gemeinsame Kathoden



"DAP" / DA4148"A" common anodes / gemeinsame Anoden

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] ¹⁾
DAN803 = DA4148K	80	80
DAP803 = DA4148A	80	80

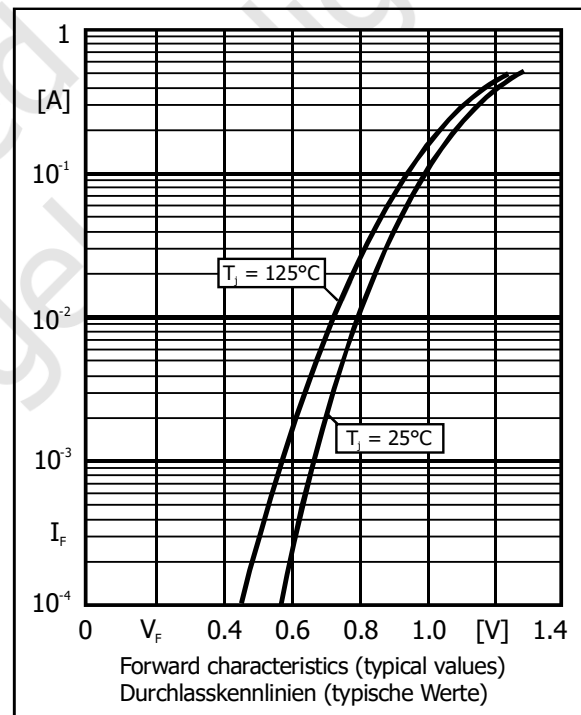
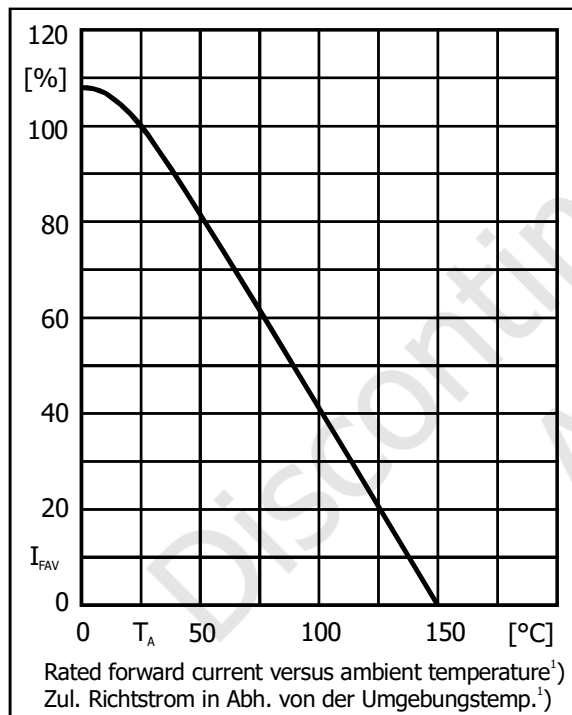
Max. average forward rectified current, R-load for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	100 mA ²⁾ 25 mA ²⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb beider Dioden	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	100 mA ²⁾ 25 mA ²⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 10\text{ mA}$	V_F	$< 1.0\text{ V}^1)$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 20\text{ V}$	I_R	$< 25\text{ nA}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	$< 4\text{ ns}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thC}	$< 85\text{ K/W}^2)$



1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden